## (9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## ⑩公開特許公報 (A)

昭54-58445

⑤ Int. Cl.²
 G 03 G 5/02
 G 03 G 13/00

識別記号 〇日本分類

103 K 11 103 K 1 庁内整理番号 7381-2H 7381-2H

同

④公開 昭和54年(1979)5月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

**创静電写真感光装置** 

願 昭53—115735

②出 願

创特

昭53(1978) 9 月20日

優先権主張

②1977年9月29日③米国(US)

**30837666** 

⑫発 明 者

ドナルド・シー・ヴオン・ヘネ アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14450フエアポート・ネトルク

リーク・ロード82

同

ジョセフ・ワイ・シー・チュー アメリカ合衆国ニューョーク州 14450フエアポート・フエアフ イールド・ドライブ37

⑫発 明 者 イーナン・チエン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州
14580ヴェブスター・マジエス

テイツク・ウエイ1220

ロバート・エヌ・ジョーンズ アメリカ合衆国ニユーヨーク州

14450フエアポート・サウス・

リツジ・トレイル118

①出 願 人 ゼロツクス・コーポレーション アメリカ合衆国コネチカツト州

スタムフオード・(番地なし)

個代 理 人 弁理士 中村稔 外4名

労 組 者

## 2.将許請求の範囲

(1) 下から殿に(a) 導電性基層と、(b) 数番層との間で、(c) 正孔を改善されてきるでを放ってきるのでは、(c) 正孔在の個とで作品を作り、(d) のの間とで作品を作り、(d) のの間とででは、(d) のの間とででは、(d) のの間のでは、(d) のの間のでは、(d) のの間のでは、(d) のの間のでは、(d) のの間のでは、(d) のの間のでは、(d) のの間のでは、(d) ののでは、(d) ののでは、

## 3 発明の詳細な説明

本発明は、幹電写真很写像、詳しくいうと新規な幹電写真感光袋値に関する。

米国特許第 3, 297, 69/ に初めて開示された 電子写真技術は、通常感光体と称する感光性プレートの面上に静電機像を形成することから成つている。該感光体は、表面上に光導電性絶縁物質の層を有する光導電性基層から成つている。通常、基層と光導電性層との間に海い障機層があり、ブレート面を帯電したときに電荷が基層から光導電性腫へ入り込むのを防止する。

動作において、ブレートは雲状のコロナイオンにさらされることにより暗中で帯電され、明暗像で落立れて放性されて感光体を選択的により像形成される。 静電機像は、ブレート面を放射させて短いまり、 横電性マーキング物質と反射させてない。 電の吸引力により像を検査させることにより集像される。トナー像を紙等の転写地材により水外的なコピーをその表にある。

ある型の野電写真感光体は、その表面に、絶像 性有級樹脂の槽で被覆された感光性物質の層を有

特開昭54-58445(2)

する導電性基層から成つている。この型の感光体 に像形成する種々の方法が、フォトグラフィック サイエンスアンドエンジニアリング

( Photograpic Science and Engineering ) 第 1 8 卷、第 3 号、 1 9 7 4 年 3 月 / 6 月 号、 萬 a s 4 負ないし第 a 6 / 頁に掲載されたマーク (Mark)氏の腧文に関示されている。マーク氏が 桂川方式及びキャノン方式と称する方法は、基本 的には♥つの工程に分けることができる。第1の 工程は絶象性被機を帯電することである。これは、 迪常多数電荷キャリヤの極性と反対の極性をもつ 直流コロナに罵出することにより遊成される。 型光導電体を用いた場合のように、正電新を絶縁 性層の表面に印加すると、光導電性基層に負電荷 が誘起されて、光導電体内へ往入されて絶縁性層 と光導電性層との間の界面において補強され、そ の結果初期電位だけが絶象性層の両端に印加され る。次に帯電したブレートが明暗像パメーンで薫 光され、同時にその表面に交流電気(キャノン) 又は初期静電荷の極性と反対の極性の直旋電気

(桂川)のいずれかによる電界を印加する。 次にそのブレートは活性放射線により一機 藤光されて 絶験性 被優層の両端にかかる 電位により 現像可能 な像を形成し、同時に光導電性層の両端にかかる 電位を 筝に成少させる、マーク氏の論文に記載された他の方式、すなわちホール( Hall) 及びパターフィールド ( Butterfield ) 方式では、 初期電圧の極性は、 多数 単布 ヤリヤと 同符号であり、 情去の場合には逆の 極性が 用いられる。

初めに被性層の両面に電圧を印加しなければならない方法、たとえば、キャノン方式の第/工程では、多数キャリヤの注入接触か又はキャリヤの内部発生能力又はアンビボーラ(Ambipolar)光導電性層を用いなければならない。初期電圧極性が多数キャリヤの反対符号である方法では、多数キャリヤの注入接触、キャリヤの内部発生能力又はアンビボーラ光導電性層が必要である。

本発明の目的は、表面上に絶縁性有機倒脂の層を有する新規な影電写具感光装置を提供することである。

さらに、本発明の目的は、機械的に可測性であ り、かつ機通な費用で容易に起立てることのでき る数値を提供することである。

さらに、本発明の目的は、 電気的に活性な構成 授業に対して機械的、 化学的、 及び電気的な保護 を与える鉄道を提供することである。

ことができるようになつている。

本発明は、ブラスチック薄膜上に可提性ベルト状で観立てられ、対策が投く、全色膨膜を与えかつ高速であるような新現な、被機された野電写真膨光体である。第1凶に図示される装施の構造は、設固上に、正孔移送物質15の層で被援された正九正人物質13の層を有する導電性基層11から成つている。電荷移送層は、設固に光導電性電荷発生物質17の薄層を有し、酸準層は比較的厚い能無性有機関節の層19で被機されている。

注入層13及び 臨荷発生層17は、電界の影響により電荷キャリヤを移送層内へ住入することができなければならないが、注入層13は暗中で、電荷発生層は光により励起される。注人された電荷キャリヤの符号は、移送層の多数キャリヤの符号と一数、すなわちことでは近でなければならない。電荷発生層17と絶数性機脂19との間の非なければならない。

好ましい実施的では、この参送層は、高い絶縁

特開昭54--58445(3)

性有磁製脂内に分散した次の式で示される分子か ら成つている。

\* 電荷移送陽 1 5 は、内部に N 、 N ′ ージフェニルー N 、 N ′ ーピス(ユーメチルフエニル)ー ( 1 、 1 ′ ーピフエニル ) ー 4 、 4 ′ ージアミン、 N N ′ ージフエニルー N 、 N ′ ーピス(ヨーメチ ルフエニル)ー ( 1 、 1 ′ ーピフエニル ) ー 4 、 4 ′ ージアミン、 N 、 N ′ ージフエニルー N 、N ′ ーピス(4 ーメチルフエニル) ー ( 1 、 1 ′ ーピ

フェニル] - 4 , 4 ′ ージアミン、N , N ′ ージ フェニルーN,N¹ ービス ( 3 ークロロフエニル) ー[ / , / ! ーピフエニル】ー4 , 4 ! ージアミ ン及びN、N¹ ージフエニルーN、N¹ ーピス ( 4 ークロロフエニル ) ー〔 / , / ′ ーピフエニ ル]-4,41-ジアミンであつてもよい世換 N, N, N', N' - テトラフエニルー[ / . / ' ーピフエニル]ー4、41ージアミンを約10重 並パーセントないしてま重点ペーセント分散させ た透明でかつ電気的に不活性な有機御脂物質から 成る。崔挟N,N,N′,N′ーテトラフエニルー [ / . / ! ーピフエニル] ー4 , 4 ージアミンを 電気的に不活性な有機樹脂物質に加えることによ り、注入層すなわち励起層からの励起された正孔 の注入を補助することができる電荷移送層を形成 する。桜送崖の厚さは、通常、約10ミクロンな いし40ミクロンであるが、との範囲以外の厚さ も用いられる。以上電気的に活性な好ましい材料 を詳細に説明した。単気的に不活性な鬱脂内に分 飲されて正孔を移送する層を形成することができ

る電気的に活性な小さな分子は、トリフエニルメ タン、ビスー(ギージエチルアミノーは一メチル フエニル)フエニルメタン、ギリ、ギョービス (ジエチルアミノ)ーはり、は『ージメチルトリ フエニルメタン、ビスーギー(一ジエチルアミノ フエニル)フエニルメタン、及びギ、ギリービス (ジエチルアミノ)ーは、は「一ジメチルトリフ エニルメタンから成つている。

特開昭54-58445(4)

結合列物質は、約20,000ないし約100,000 の分子重(Mw )を引し、悖に、約50,000な いし約100000の範囲内にあるのが好ましい。 電荷住入層13は、必送層15と基層11との間 に有り、貯電荷が装置の表面に印加されるとき注 人正孔を啓送順内へ作用させるようになつている。 第3a凶を参照すると、装置に負電荷を印加した 場合が凶示されている。このようた希望時に、正 孔が基体から基体と注入層との間にある界面へ誘 起されて移送層内へ圧入され、絶数層と電荷発生 勝との間の界面に移動して絶縁層の両面に加わる 世界を形成する。代表的な或荷注入物質は、金及 びグラフアイトである。ニッケル基体を用いたよ りなある妖魔では、導電性遊体は、正孔格送物質 の層と注入界面を形成し、別個の注入層を必要と しない。

在入物質の層が付着する導電性基体は、適当な 導電性物質から作られてよい。それは、平面ブレ ート又はドラム状装置を用いる場合のように駆く てよいが、もちろんエンドレスベルトの形状の感 光体に用いる場合には可撓性でなければなりない。
この装置では、連続的で可撓性のニッケルベルト
又はアルミニウム蒸着マイラー(Mylar)等の金属蒸着ボリマーのウエブ又はベルトを用いてもよい。金の場合にかける蒸冶や、グラフアイトの場合にかける格別付着を速常のハミクロンないしょ
ミクロンの範囲の厚さまで行なうことにより基体に注入界面が加えられる。移送層は、速常祭却コーティング技術により電荷注入層の上に付着される。

感光装置の初期帝電後、正の直流コロナ义は正パイプスされた交流コロナで2次帝電され、それと同時に像形状で露光されて第20図に図示するように装置の表面電位を等にする。この図では、電荷分布は、絶縁被復居と電荷発生層/移送層/界面の組合せに対して等しい容量値をもつと仮定して図示されている。

電荷発生光導電性物質は、電荷移送層の鼻光表面上へ蒸着されている。発生層が光励起により電荷キャリヤ(電子-正孔対)を発生し、正孔を正

本発明の感光体の最上層を構成する絶数性樹脂は、単純に対する高い抵抗と、高い電気抵抗又は高気性を対象性を対象性であるとももに舒電新を結合ですることをもに移動を対象としている。使用の例は、ポリスチレン、アルキド樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエテル樹脂、ポリエチレン樹脂、少なくクロンである。絶縁層の厚さは、少なくクロションであるが、それは過 約20ミクロシー

ンないし約50ミクロンである。

、さらに、本発明を以下の実施例により説明する。 実施假!

本発明による感光装置は、次のように形成される。

厚さのよりの金の薄層がアルミニウム基体上に 真空蒸着され正孔注入界面を形成する。よの重量

特別昭54-58445(5)

第3図は、単名図に示した実験装置を用いて作 成された電子写真放電曲線を扱わす。第4 図では、 ドラム21は、帯電コロトロン23、(河時に像 単光し感光衰速を2次帯電する手段から成る)第 光ステーション25、全面照射ステーション27 及び消去ステーション29を速速して時計回り方 向に回転する。像鼻光ステーションには、キセノ ンランプと+300ボルトの直流パイプス電圧に よりパイアスされた周波数60Hz 、実効値約7

曲韻Aは、正帝電、論光及び消去から成る傑準 の電子写真装置を用いて作成された。との実験に かいては、装匠の上部における高い正キャリアの 移動度や励起のために正覆電が用いられた。(病 **4凶のP」、P。、P。、P。 及びP。 で示した** I うに)プローブを用いてよ箇所のほ圧が測定され た。男は図に示されたデータはブローブ4(ピ。) によるものである。これらのデータでは、鮮光時 のシャント装置がオフにされ俏去は、タングステ ンランプにより達成された。 曲線 4 及ひしのデー タは、前述した帯電、像事光及び同時再帯電、全 面鼻光及び前去方法を用いて作成された。との装 雌では、姿性の表面電位は、P。 により側定され るように毎光ステーション25において零ポルト に切換えられる。初期帯電は、負、すなわちこの 実職の多数電荷キャリャの符号と反対である。曲

線 B 及び C のテータは負電位であり、全面構光を に られる。消去は、何時鄭光/シャント装置を 用いて実現された。

3つの歯離は、すべて高い現像領域に対応する 高現像電位を表している。そのデータは、P。 に おける側定により決定された残留電圧形成や、大 きな現像電位の持続なしで流遠方式で作成された。 4 図面の簡単な説明

第1凶は、本発明による層状の感光装置の構造 を示す凶である。

第2a凶ないし第2e図は、第1凶の装置の動作を示す図である。

第3図は、電子写真放電曲線を示す凶である。 第4図は、実験用の像形成ドラムの図である。

- 11 … … 基層 13 … … 正孔在入層
- 15 … … 正孔移送層 17 … … 電荷発生層
- 19 ... ... 絶最有機樹脂 21 ... ... ドラム
- 2 3 … … 帯電コロトロン 25 …… 鮎光ステーション
- 2 7 ……全面照射ステーション
- 2 9 …… 梢去ステーション





